2024.Oct. Quarterly

Lecture -

「物質・材料の研究の醍醐味」 東京科学大学元素戦略 MDX 研究セン 栄誉教授・特命教授

細野 秀雄 先生

À la carte — 4

京の台所を訪ねて18 ムガール

Information — 5

サムコ辻理寄附講座 「先端材料科学講座」 の 第1期生に学<u>位記が</u>授与

SEMICON Japan 2024お知らせ

サムコ科学技術振興財団 2024年度 第8回研究助成金贈呈式

および記念講演 報告

Technical-Report — 6

トレンチ型 SiC MOSFET の実現に向けた ICP エッチング技術

~「天授庵 | で借景と共に

紅葉絵巻を楽しむ~

「絶景かな、絶景かな」という有名なセリフは、かの石川 五右衛門が南禅寺三門の上から桜を愛でて発したセリフ ですが、それに負けじと秋には塔頭「天授庵」には紅葉 スポットが有ります。庭園に枯山水庭園と池泉回遊式庭園の 2種類があり、赤と黄の鮮やかな借景と共に、それぞれの美

サムコ科学技術振興財団 2024年度 第8回 研究助成金贈呈式 記念講演「物質・材料の研究の醍醐味」

サムコ科学技術振興財団 2024年度 第8回研究助成金贈呈式が、9月20日に京都リサーチパークにて開催されました。贈呈式に続いて行われた記念講演に 細野秀雄先生(東京科学大学元素戦略 MDX 研究センター 栄誉教授・特命教授)をお招きし、講演を行っていただきました。記念講演の要旨をご紹介いたします。



細 東京科学大学元素戦略 MDX 研究センター 栄誉教授·特命教授

1977年3月 東京都立大学 工学部 工業化学科 卒業 東京都立大学 大学院工学研究科 工業化学博士 修了 1982年3月

略 歴 1982年4月 名古屋工業大学 工学部無機材料工学科 助手 1988年9月

ヴァンダービルト大学 客員准教授 1990年3月 名古屋工業大学 工学部材料工学科 助教授

1993年7月 東京工業大学 工業材料研究所 助教授 1995年4月 岡崎国立共同研究機構 分子科学研究所 助教授 1997年4月 東京工業大学 応用セラミックス研究所 助教授

東京工業大学 応用セラミックス研究所 教授 1999年4月 2012年4月 東京工業大学 元素戦略研究センター センター長

2019年4月 東京工業大学名誉教授·栄誉教授

東京工業大学 元素戦略研究センター 特命教授 2019年4月 2020年4月

国立研究開発法人物質・材料研究機構 特別フェロー・グループリーダ (現任) 東京工業大学(現東京科学大学) 2023年4月

元素戦略 MDX 研究センター 特命教授 (現任)

2012-2018年 日本学術会議会員 2017年~ 王立協会外国人フェロー

Otto-Schott Research Award (Erndt-Abbe Foundation) 表彰歴

1994年 W.H.Zachariasen Prize

1998年 市村学術賞

2000年 井上学術賞

2009年 藤原賞、紫綬褒章、Ernst Matthias Prize

2010年 朝日常

2011年 業績當(応用物理学会)

2012年 仁科記念賞

2013年 本多記念賞、トムソン・ロイター引用栄誉賞『鉄 系超伝導物質の発見』

2015年

James McGroddy Prize for New Materials(米国物理学会)、日本化学会賞·日本学士院賞·恩賜賞 2016年

日本国際賞 (Japan Prize)、日本セラミックス大賞 (日本セラミックス協会)

Von Hippel Prize (Materials Research Society) 2018年 Eduard Rhein Technology Prize (Eduard Rhein Foundation) 2022年

Karl Ferdinand Braun Prize (Society for 2023年

Information Displays)

▶ なぜ透明酸化物の電子機能を目指したか

サムコ科学技術振興財団の研究助成金を受けら れました10名の研究者の皆様、おめでとうございま す。本日は「物質・材料の研究の醍醐味」と題してお 話をします。まずは材料と物質の違いについてお話し ますが、材料とは"物質の中で人類の社会に直接役 立つもの"だと思います。膨大な物質群の中から材 料にジャンプできるものは極めて少ない。その時代や 社会のニーズによっても変わってきますが、物質の中 からどうやって材料にジャンプさせるかが大切です。 人類社会に役立てるため、材料科学は非常に良い分 野であると思っています。

現代社会を支えているのは鉄とシリコンです。両方 とも自然界には無いもので、鉄鉱石や水晶が元になっ ています。人類は、酸化物から酸素をはぎ取り、高純 度化してドーピングすることで新しい機能を発見して きた歴史があります。1999年、私はJST (科学技術 振興機構)の戦略的創造事業ERATOプロジェクト で「透明電子活性酸化物」をテーマにした研究を開 始しました。透明電子活性は私の作った造語です。そ の背景には、1986年の銅酸化物での高温超伝導の 発見とそれに続く強相関酸化物の固体電子物質の研 究は遷移金属酸化物が新しい電子機能の宝庫である ことが明らかにされたことがありました。当時、私はセ ラミックスを専門としており、意識的に非遷移金属酸 化物(透明な酸化物)の研究に集中しました。ところ が巡り巡って最後の方では鉄の超伝導に至る訳です が、振り返れば非常に面白い経緯でした。私が目指し たのは、地球上に豊富にある資源(ありふれた物質) で、伝統的窯業製品(セメント、ガラス、陶磁器)では なく、半導体のように電子が主役となる機能を見つけ ようというものです。そのためには、基になる科学をき ちんとやって攻めようと考えました。私が触発された のは1935年に米国デュポン社が開発した合成繊維 のナイロンです。ナイロンは「水と空気と石炭から生 まれた絹よりも柔らかく鋼よりも強い繊維」と宣伝され ました。最初の物質から似ても似つかぬ性質が実現 しているわけです。これと同じことを酸化物で作りた い!という想いが私のモチベーションになりました。

材料研究のスキームにおいて"機能、構造、元素" の3つがありますが、結局のところ世の中が求めてい るのは"機能"です。材料が有機だとか無機だとか は研究者の内輪の話で本来は関係ありません。いか に"機能"を実現するかがポイントです。元素の伝統

的なイメージを刷新し、その常識を覆すことで新しい 相関関係を発見できるかがキーになります。

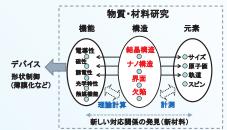


図1 元素と機能の関係

また、私には3つの夢があります。①.アモルファス シリコンを凌ぐ半導体、②.銅酸化物を凌ぐ新超伝導 物質、③. 温和な条件で働く高性能アンモニア合成 触媒、です。だいたい半分くらいはできていますが、残 りの人生でどこまでできるか試してみたい思います。

私の研究成果のハイライトと思っているものを図2 に示します。

酸化物を使った薄膜トランジスタ(TFT=Thin <u>Film Transistor</u>) は有機 EL テレビを始めとするか なりのディスプレイ類に使われております。石灰とア ルミナという酸化物から成るアルミナセメントの原料 12CaO·7Al₂O₃ (C12A7) は、1kg 5円程度の安 価な物質であり、エレクトライド、グリーンアンモニア の合成触媒といった領域に活かされています。また、 従来の常識を覆したといわれる鉄系超伝導化合物 の発見です。

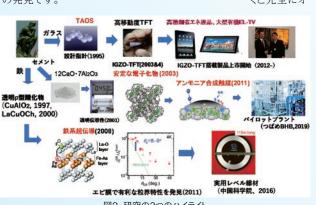


図2. 研究の3つのハイライト

▶酸化物半導体 (IGZO) TFT の進展

液晶ディスプレイは、後ろにバックライトがあり液晶 を2枚の偏光板で挟んで電圧を加えてやると、液晶 分子が回転して光が出てくるという構造です。スイッ チの役割を果たしているのが TFT です。 液晶は動き が遅いため、切り替えの速いトランジスタは不要であ りアモルファスシリコンで事足りていたのですが、有 機ELになるとバックライトが不要になり、流れる電流 量と発光強度が比例するため、電子の動きの速い TFT が必要になります。これからはアモルファスシリ コンではなく有機半導体の時代と言われるようになり ました。私はそれを聞いてそれならアモルファスの酸 化物半導体なら簡単にできると密かに豪語しIGZO-TFTを作り実用化されました。IGZO-TFTはインジ ウム (In)、ガリウム (Ga)、亜鉛 (Zn)、酸素 (O)か ら成る酸化物半導体で、アモルファスシリコンの30倍 の性能が出ます。私たちが2004年に「Nature」へ 論文を掲載した際は、トップデータではなく誰が作って も再現できる値を掲載したことで、追試を行った多く 研究者からそれ以上の値が得られ、間違いないと注 目され、研究が広く普及しました。アモルファスでトラ ンジスタになった例はアモルファスシリコンを除くとあ りません。アモルファスは結合の角度が少しズレると 電気の通りが極端に悪くなります。電子が動くn型半 導体を想定したので導電路となる伝導帯の底だけを 考えます。金属イオンの空のs軌道で空間的に大きく 広がっているものを選びました。イオンの大きさを描く とカチオン同士は接しませんが、空の軌道の半径で描 くと完全にオーバーラップしている。ここに電子を入

れたらアモルファスでも電気が良く流 れるはずです。この発想で非常に良 いトランジスタができました。IGZO-TFTとアモルファスシリコン-TFTに 同じ電圧をかけた場合、IGZO-TFT の方が格段に性能が高くなりました。 トランジスタはオンオフを切り替えて 電流の流れを制御する素子です。ア モルファスシリコンではオフの場合で も微弱ながら電流が流れてしまいま す。ディスプレイでは99.9%の時間は オフになっており、オンになる時に画 像が切り替わっています。オフ時の消 費電力が小さいという点でもIGZO-TFTの方が優れています。シリコン

のメモリーでも同様、データが消えないように1秒間にかなりの回数のリフレッシュをしています。オフが極めて小さいものを作れるとリフレッシュがいらなくなり、消費電力が大きく減少します。IGZOは現状のディスプレイの領域は概ね制覇したため、次はメモリーへの応用が注目されています。

1995年、アモルファスの国際会議では800件の発表のうち、酸化物の発表は私の1件のみでした。2012年以降iPad、スマートフォン、液晶テレビ、スマートウォッチなどにIGZO-TFTは実用化され、2016年の大型有機ELテレビの上市で市場が大きく開けました。ディスプレイ産業は年15兆円規模の巨大産業になり、そのうち3分の1が酸化物半導体で動くのが今の市場予測になっているようです。有機ELテレビは年800万台に迫る勢いです。将来的に期待されるのはシリコンメモリーとの結合です。あと数年で実用化の可否が判断されるのではないかと思っています。

振り返れば、ディスプレイ装置に関する学会である SID (The Society for Information Display)の酸化物 TFTのセッションができたのは2007年のことでした。昨今では一番大きなセッションの1つになっています。学術的なインパクトでは、私たちが2003年(結晶IGZO-TFT、Science誌)、2004年(アモルファスIGZO-TFT、Nature誌)に出した2つの論文の引用回数は合計で1万2千件を超えています。特許の引用件数も4万件を超え、特許のライセンス収入はスポンサーであった科学技術振興機構(JST)では赤崎勇先生の青色LEDに次ぐ歴代2位となっていると聞いています。

▶ 鉄系超伝導体の発見

超伝導の歴史は約110年前に遡ります。当時の科学界では様々なガスを液体化することが盛んに行われており、1908年、オランダのカメリン・オンネス氏がヘリウムを4Kまで冷却し、初めて液体ヘリウムを手に入れました。彼は様々な金属片を冷やし、電気伝導度を測定したところ、水銀は超低温状態にすると電気抵抗がゼロになることを見出しました。1911年、超伝導の発見の瞬間です。

超伝導は2つの電子が瞬間的にペアを作り、結晶 全体が1つの電子の状態になることです。2つの電子 を瞬間的に結び付けるのが格子の振動です。よって、 超伝導は真空中では起きないのが特徴です。但し、 鉄、ニッケル、コバルトなどは大きな磁気能率を持って いるので、電子のスピン方向が一方向に並んでしまい ます。時間的に動かずにスピンが並んで得をするエネ ルギーが、電子がペアを作って得をするエネルギーよ りも大きいため、超伝導にはならないと信じられてい ました。 私たちは電子のドーピングで鉄のスピンの並 びを壊すことで、超伝導を発現させました。阻害して いるものを取り除くことで超伝導を実現したといっても いいでしょう。2008年4月に発表した鉄系超伝導体 の発見の論文は、この年末までに665回引用され、こ の年に発表されたすべての論文の中で世界一を記 録しました。実はこの論文は最初にScience 誌へ投 稿したら3日で却下されまして、ほぼ1年経ったら同じ Science 誌がBreakthrough of the year 2008に 選出したという顛末がありました。その直前の2006 年に、2013年頃には高温超伝導の研究は絶滅する であろうということを予期するレポートが発表されて いたのですが、私が発表を行った2008年の東京、 2009年の米国の物理学会での会場は大勢の参加者 で賑わい、酸化物系高温超伝導の発見以来の新大 陸の発見と呼ばれました。

超伝導は温度を上げ過ぎたり、高い電流を流したり、強い磁場の中だと消えてしまいます。超伝導の中では強い磁場を作るのが最も大切になりますが、実用的なものを作るのは意外と大変です。また、多結晶で作るためには、2つの単結晶の角度がズレると、どのくらいTc(臨界温度)やJc(臨界電流)が変わるかが非常に大きな問題です。また、コストが高いことが実用化の高いハードルになっています。そのような中、

鉄系超伝導は銅系超伝導に比べて2倍強まで角度がズレてもJcが保持できるとという結果も見出しました。ワイヤーの作製は、鉄系超伝導物質の粉体を金属製のチューブに詰めて押しながら引っ張るというパウダー・イン・チューブ法では可能です。この線材化の研究は中国が最も力を入れています。今は加速器に使う目的で長さ1kmの超伝導線材の作製を目指しているようです。ちなみに、最近では米国の核融合の巨大投資も相まって世界的に超伝導の線材の供給が間に合っていない事態になっています。

▶ エレクトライドの材料科学、物質の展開と グリーンアンモニア合成触媒の進展

最後は、電子がアニオンとして働く化合物 "エレクトライド(電子化物)"の話をします。アルカリ金属を液体アンモニアで溶かすと綺麗な青色になります。これを結晶化しようとしたのが米国のJames L. Dye先生で、イオン結晶中のアニオンが化学量論的に電子と置き換わった "エレクトライド(電子化物)"が1983年に誕生しました。ただ、あまりに化学的・熱的に不安定(低温&不活性ガス雰囲気下でのみ安定)であり、物性研究は困難でした。そのため、安定なエレクトライドの実現が最大の課題でした。当時の私はエレクトライドという名前は知っていましたが、あまり意識はしておらず、後々、私たちが作った電子をドープしたC12A7がエレクトライドになっていることに気付いて



図3.王立協会で開催されたシンポジウム の際に、Humphry Davy卿の絵画 (上)の前での、細野秀雄先生(左前)、 James L. Dve先生(右前)

発表をしました。エ レクトライドの研究 は、19世紀の始め の英国Humphry Davy卿が溶媒和 電子を発見したこ とに始まり、2000 年代以降、高圧工 レクトライド、2次元 エレクトライド、アモ ルファスエレクトライ ドなどの研究が進 み、現在ではエレク トライドはそこまで 珍しくないことが分 かってきています。

私たちが作った C12A7は一見すると複雑な構造に思えますが、石灰 とアルミナを混ぜて千度くらいにすると誰でも簡単に 作れます。結晶格子は、直径約0.4nmの空隙を持つ 籠状構造 (ケージ) からなり、この結晶格子は正電荷 を帯びているため、ケージ内部に酸素イオンを取り込 んで安定化します。さらにこの酸素イオンを他の陰イ オンで置換することによってC12A7は様々なユニー クな機能が発現します。電子を引き抜くための方法 として、金属のチタンを蒸着して加熱する方法があり ます。電子濃度によって透明なガラスの状態から、だ んだんと緑色になり、更に色が濃くなると最終的に黒 色になります。最初は10-10という立派な絶縁体なの ですが、少し電子を入れると伝導力が急激に上がり、 ある一定まで進むと金属になります。この金属的に なった試料を冷やすことで超伝導になります。つまり、 絶縁体、半導体、超伝導体を1つの物質でできたの です。ここで私が言いたいことは物質によって、絶縁 体、半導体、超伝導体が決まっている訳ではなく、知 恵と工夫次第で変えられる!ということです。

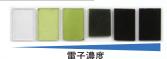


図4. 電子のドープによるC12A7単結晶の色の変化

ただ、C12A7は透明なITO (Indium Tin Oxide)で使えるほどの伝導性はないと思っていました。普通のアニオンは原子核があって、外側に電子がありますが、アニオンとして働く電子がユニークなのは、原子核を持たないことです。仕事関数が小さい他の材料に

は、アルカリ金属の K (カリウム)、Cs (セシウム) などがありました。これらの金属はあまりに反応性が高く、通常の雰囲気にさらすと爆発的に反応していまいます。一方、C12A7エレクトライドはポケットに入れて持ち運べるほど安全です。この性質を活かすためにアンモニア合成をやってみようと思い立ちました。

アンモニア合成の歴史は、19世紀頃の欧州の食 糧危機問題から始まります。その際、植民地や海軍を 擁さなかったドイツが国をあげてアンモニア合成の研 究をしました。まさに学問の試練の場だったのです。 鉄を主体とした触媒上で水素と窒素を400~600°C、 200~300atmの状態で直接反応させてアンモニア を生産する方法が、Fritz Haber氏とCarl Bosch 氏によって生み出され、1913年以降の産業革命に よって生じた人口爆発を支えています。もしハーバー・ ボッシュ法が無ければ、現在の3人に2人は生きてい ないという統計もあります。こんな過酷な条件下に耐 える反応容器に使える金属はありませんでしたので、 この方面の研究も進展しました。ドイツの鉄鋼業の 強さの秘訣はここにあるようです。現在はアンモニア の輸送に船やタンクローリーを使っていますが、コスト が高く、安全性の点から後者は禁止されている国も あります。そのため、アンモニアを必要なところで作 りたいというニーズがあるのではと私は考えました。 C12A7は砕くとケージが割れて表面が絶縁体になっ てしまう問題もありましたが、丹念に条件を探して表面 を再構成させる方法を見出しました。そして目論見通 り、従来の触媒よりもかなり高い活性が得られました。 また、エレクトライドという新物質を触媒に応用したと いう新機軸も関心を呼んだようです。その結果、私た ちが2012年に論文を出して以降、年50件以下だっ たアンモニア合成触媒に関する論文数が急速に跳ね 上がり、現在は年1,000件を超えています。

昨今では温和な条件下で合成する「グリーンアン モニア」の研究が、世界的に盛んになっています。再 生可能エネルギーで発電した電力で水を電気分解 し、水素と酸素に分解します。電気分解によって取り 出した水素を、窒素と反応させます。ハーバー・ボッ シュ法のような大型設備も不要で、低温かつ低圧力 での製造法でコストも掛からないであろうという構想 です。この新しい触媒とそれを生かすプラントの実用 化を目指す、つばめBHB社が2017年に設立されま した。BHBとは「Beyond Haber-Bosch」の略 です。現在、18社から約60億円の出資を受けてい ます。大学のラボの実験だけでは産業界には信用さ れませんので、2019年にパイロットプラントを立ち上 げ、製造や耐久性の確認を始めました。現在まで5 年間連続運転を行っておりますが、全く支障なく動い ているようです。ハーバー・ボッシュ法で得られるの と同程度のアンモニア濃度を温和な条件下で達成で きる新触媒を実現し、その後段で開発した膜分離で アンモニア濃度を高め、Beyond Haber-Boschを 成し遂げたいというのがこの企業の開発目標です。

▶ 材料研究のすすめ

最後に若い研究者の方々へのメッセージです。新 しい画期的なものは、これからも研究者個人と用意 された偶然に依存する割合が高いと思います。AI は効率化のためにはとても有効ですが、画期的なも のを生み出すのは難しいでしょう。なかなか王道は 無いのが実態です。材料研究は非常にやりやすいと 私は感じています。それは個人の好みに応じた研究 の仕方ができるからです。基礎もあれば応用もあり ますし、許容範囲が凄く広いのが材料研究の特徴で しょう。研究者の個性には"探索(勘)、理論・モデル (頭)、プロセス(腕力)"の3つがベクトルとして存在 しますが、研究者個人によって異なる個性が活かせ るからです。もし進路に迷ったら材料分野を選んでみ るのがいいのでは、というのが私の個人的な経験で す。もちろんデバイスがやりたければデバイス化に向 けた研究をやればいいですし、非常にフレキシブルな 研究ができるのが材料研究の魅力だと思います。こ 清聴ありがとうございました。

40年近くにわたって京都でインド料理を提供してい る老舗"ムガール"。オーナーシェフの平田幸秀さんが 『和の心』をモットーとし、独自のインド料理を追求して きた軌跡は、古くも常に新しい歴史となっています。





木屋町御池を少し上がると、右手のビ ル二階にインド国旗が見えてきます。店名 "ムガール"は、インド史上最大のムスリム 王朝の名で、北インドで栄華を極めたこの 王朝時代ゆかりの宮廷料理の流れを汲み ます。インドの要人なども訪問する格式の 高い店の扉の向こうには、高級感が溢れ るスペース (テーブル36席・カウンター4 席の計40席)が広がっていました。

創業は1987年。平田さんは当時、同志 社大学に在学する1回生で、学業と仕事 を両立することになりました。「世界的に はメジャーな料理が日本にはまだ普及して いない時代で、"食"を通じてインドの文化 を広く伝えようと思いました」と平田さん。

インド人シェフを雇って共に働きながら 料理を覚えました。インド料理の専門書の 日本語版がなく、英語の辞書を引きながら 洋書も読んで学びました。インド料理の需

要がない当初は、スパイ スや食材が満足に手に 入らず、厳しい環境にさ らされたそうです。

"インド料理は辛い" というのは誤ったイメー ジであり、実際その内容 は非常に多彩で、味もさ まざまです。「日本の食 文化にインド料理が入っ ていく中で、ゴージャス なものをご提供しようと

思いました。メニューの基本は、イスラム 文化の影響を強く受けた北インドの料理 で、伝統的なベジタリアンが多い南インド 料理も一部あります。ヒンズー教の方は ビーフを、イスラム教の方はポークを食べ ることができません。どちらの方にも安心 してご来店いただけるよう、使用する肉は チキンやマトン・ラム、シーフードを選びま した」

北インド料理の一例とし て挙げるのは、骨付きラ ムのスネ肉をスパイスと共 に煮込んだラムローガン ジョシュ(2,200円税込)。 今やおなじみになったパン "ナーン"は、北インド特 有のタンドール(土釜)で 焼かれており、この釜でチ キン、マトン、フィッシュを

調理したタンドリー炭焼き料理もあります。

「インド料理のルールを守りつつ、少しず つ新しいことを取り込み、古いものを捨て るトライ・アンド・エラーを繰り返し、残った のが今のレギュラーメニューです」

インド料理の魅力を知るのに入り口とな る料理は、ランチタイムのAセット(1.100 円税込)です。肉系、野菜系からなる計6 種類のカレーから好みの2種類を選ぶこと ができます。またこのセットではナーンかラ イス、マサラチャイかコーヒーを選べます。 アラカルトメニューは、インド料理のバリ エーションの豊かさをいっそう感じさせる 内容になっています。

ランチタイムのお客様の9割は日本人で す。昼夜を合わせた全客数の割合につい ては、7割が外国人、3割が日本人。「日 本でなぜこんな美味しい料理が作られて いるのか | とインド人のお客様が驚嘆する ほどで、口コミサイトや、周辺の高級ホテル のコンシエルジュを通じて"ムガール"の 評判が伝わり、インド系に限らず、ハイクラ スの外国人が来店しています。一方、世 代交代しながら長年贔屓にしてくれる日本 人のお客様も珍しくありません。

国内外のお客様の舌を確実に満足さ せていますが、「これからも日本人のお客 様にも、インド人のお客様にも喜んでいた だかなければなりません。インド料理はま だまだあるのですが、私どもがそれを提供 できていません」と平田さん。インドに限

> らず、インド系移民が多 いロンドンのインド料理店 も訪ねて着想を得ようと 努めるなど、全速前進す るオーナーシェフのトラ イ・アンド・エラーはこれか らも続き、新しい料理が 反響を集めるたびに"ム ガール"の魅力がさらに 増していきます。



回见



京都市中京区上樵木町496 アイル竹嶋ビル2F TEL 075-241-3777

URL http://www.kyoto-mughal.com/

営業時間 ランチ 12:00~15:00 (ラストオーダー14:30)

ディナー 17:00~22:00 (ラストオーダー21:00)

定休日 火曜日

京都市営地下鉄「京都市役所前」駅より徒歩5分 京阪電車「三条」駅より徒歩8分



「ラム・ローガン・ジョシュ」骨付きラムのスネ肉をスパイスと 共にトロトロになるまでじっくり煮込んだ濃厚な深い味わい



サムコ辻理寄附講座 「先端材料科学講座」の第1期生に学位記が授与

9月25日、国立大学法人京都工芸繊維大学にて、材料科学分野の博士 後期課程の研究者を育成するサムコ辻理寄附講座 「先端材料科学講座 | の第1期生2名の学位記授与式が実施されました。

当講座は、日本の材料科学の発展、企業の研究者・技術者の育成および グローバルな産業競争力の強化、特に45歳前後のベテラン社員の再教育 (リスキリング)を目的としており、2022年4月に開講しました。

第1期生の2名には将来の日本の先端企業の中核人材となる研究者とな られるよう益々の活躍を期待しております。人材育成によって日本の産業界 の科学力向上に繋がるよう、当講座による研究者の育成を続けてまいります。



SEMICON Japan 2024お知らせ SEMICON®

JAPAN

期 2024年12月11日(水)~13日(金) 会

会 場 東京ビッグサイト

ブースNo 4406 (東4ホール)



SEMICON Japan 2023 サムコブースの様子

半導体製造装置や材料、関連技術が一堂に会する展示会 「SEMICON Japan 2024」が東京ビッグサイトで開催されます。

当社は電子デバイス製造向けクラスターツールシステム「クラ スターH™ |、SiCトレンチ加工やプラズマALD(原子層堆積) の最新のプロセスデータ、新たに販売を開始するALE (原子層 エッチング)装置、生産性を大幅に向上した新プラズマCVD装置 「PD-2201LC」、ウエハー枚葉式 Aqua Plasma 装置や金の 還元データを紹介します。

当社ブースは東4ホール入口正面にございます。今年、設立45 周年を迎えた当社では、皆様に感謝の気持ちを込めて記念の桧 桝をご用意しております。皆様のご来場を心よりお待ち申し上げて おります。

サムコ科学技術振興財団 2024年度 第8回研究助成金贈呈式および記念講演 報告

9月20日、京都リサーチパークにおいてサムコ科学技術振 興財団 (理事長 辻理) の2024年度 第8回研究助成金贈 呈式が開催され、若手研究者10名にそれぞれ200万円、総 額2,000万円が贈呈されました。式典後には、東京科学大学 元素戦略MDX研究センター 栄誉教授・特命教授で、物質・ 材料研究機構の特別フェローの細野秀雄様による記念講演* が行われました。

研究助成対象者10名と研究課題は財団の ホームページをご覧ください。

第8回 研究助成金贈呈式および記念講演

※細野秀雄様の記念講演につきましては、本 **52MCD NOW** の2-3頁をご覧ください。



読者アンケートのお願い

サムコナウへのご意見・ご感想をぜひお聞かせください。 今後の誌面の改善に役立てさせていただきます。

アンケートは こちらから 🕼



トレンチ型SiC MOSFETの実現に向けたICPエッチング技術

サムコ(株) 開発部

■ はじめに

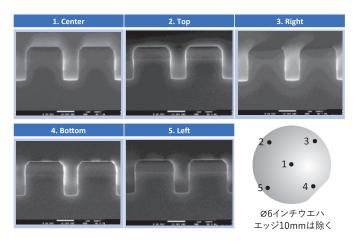
4H-SiCパワーデバイスの一例としてMOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) がある。従来はプレーナー型MOSFETが開発されてきたが、「低オン抵抗化」などの高効率化の要求に応えるためトレンチ型MOSFETが注目されている。当社はトレンチ型SiC MOSFETの製造に必要なICPエッチング装置によるトレンチ加工に取り組んできた¹⁾。今回は、主流であるØ6インチのSiCウエハを用いた最新のトレンチ加工技術について紹介する。

■ 実験および結果

SiCトレンチエッチングにおける重要なポイントは「高エッチングレート」、「トレンチ形状制御性」、「トレンチ底部のラウンド形状」の3つである。今回は、これら3つのポイントを満たすためICPエッチング装置「RIE-800iP/800iPC」を使用してØ6インチウエハを処理する実験を行った。

開口幅約 $1~\mu$ mのトレンチパターンを垂直にエッチングした例を図1に示す。エッチングレートは700 nm/min以上、マスクとの選択比 (SiC/SiO₂) は5以上、トレンチ側壁角度88 ~ 89°、エッチング深さの均一性は±3%以下と良好な結果が得られた。これまでのエッチングレートは450 nm/minであったが、今回プロセス条件を最適化することで1.5倍以上まで改善した。さらに、マスク選択比の減少などの制限はあるが、エッチングレートは最大850 nm/minまで高めることができる。開口幅0.8 μ m ~ 2.0 μ m でのトレンチ形成の実績があり、より微細なパターンにも対応していく。

次にトレンチの形状制御、トレンチ底部のラウンド形状加工に



·SiCエッチングレート: >700 nm/min

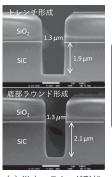
·面内均一性: ±2.1%

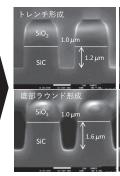
·SiC/SiO2選択比: >5

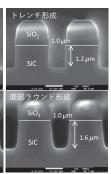
・トレンチ側壁角度: 88~89°

・マイクロトレンチレス

図1. RIE-800iPCによるSiCトレンチ加工







(a) 従来のラウンド形状

(b)新規のラウンド形状 (c) 新規のラウンド形状 (中央) (端)

図2. RIE-800iPCによるSiCトレンチ底面のラウンド加工

ついて紹介する。トレンチ構造の場合、ゲート電圧印加時にトレ ンチ底部の角に電界が集中することで、ゲート絶縁膜が破壊さ れる懸念がある。この問題を回避するためには、トレンチ底部を ラウンド形状にする必要があり、従来は高温アニールによってラ ウンド形状が形成されている2)。近年は、アニールに代わりドライ エッチングでラウンド形状を形成する要求が増加している。当社 はこれまでもトレンチ底面の角をラウンド化するドライエッチング プロセスを開発してきた。今回、プロセス条件を最適化しトレンチ 底面全体をスムーズなラウンド形状にする技術を開発した。図2 に加工例を示す。図2 (a) は従来のプロセス条件でエッチングし た結果である。トレンチ底部の角のみラウンドに加工できている。 図2 (b)と図2 (c)は新たに開発したプロセス条件でØ6インチウ エハの中央と端をエッチングした結果である。ウエハ面内5点の エッチング深さの均一性は±3%以下であり、ラウンド加工無し の形状と同等の均一性が得られている。さらにラウンド形状のば らつきも抑えられており、良好な結果が得られている。

■ おわりに

今回はトレンチ型 SiC MOSFET の製造に必要な SiC トレンチエッチングの最新結果について紹介した。エッチングレートは1.5 倍の700 nm/minまで向上し、ラウンド形状の制御および均一性も改善している。今回紹介したのはØ64ンチでの結果だが、Ø84ンチでのプロセス開発も進めている。また、トレンチ型 SiC MOSFET の製造で必要となるゲート絶縁膜成膜 (CVD および ALD) や電極加工など豊富なプロセスデータと実績を有している。当社は、SiC に加えて、GaN や Ga_2O_3 などのさまざまなワイドバンドギャップ半導体の加工や成膜に関する知見を有しており、持続可能な社会の実現に向けてパワーデバイス分野の発展に貢献していく。

■参考文献

- 1) Samco NOW vol.104 Technical-Report, 2019年1月
- 2) Yasuyuki Kawada et al:Shape Control and Roughness Reduction of SiC Trenches by High-Temperature Annealing, Japan Journal of Applied Physics 48, 116508 (2009)

Samco NOW vol.127

ウエハ間再現性:<±1.5%

2024年10月発行

バックナンバーも、こちら*〔〕* からご覧いただけます。



